

[第 8 回目] アンペールの法則

考える内容

- ・ 磁場についての基本法則

今日の授業の目標

- ・ 磁場のガウスの法則 [磁場には湧き出し (真磁荷) が無い]

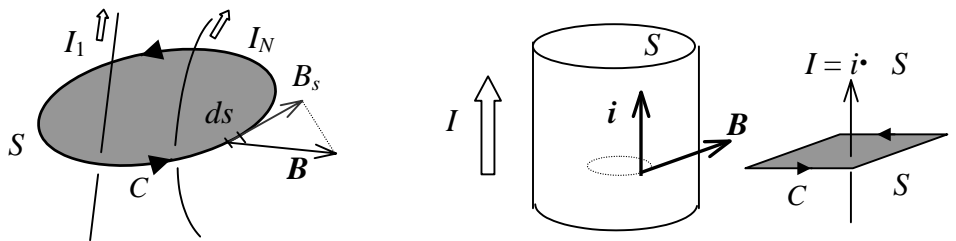
積分形 $\Phi_m = \int_S B_n \cdot dS = 0$ (ある閉曲面 S 上で)

微分形 $\text{div} \mathbf{B} = 0$ (ある場所 r で) 第 2 の基本法則

- ・ アンペールの法則 [磁場は電流によってできる]

積分形 $\oint_C B_s ds = \mu_0 \sum_i I_i = \mu_0 (I_1 + I_2 + \dots + I_N)$ (ある閉曲線 C 上で)

微分形 $\text{rot} \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{i}$ (ある場所 r で) 第 3 の基本法則 (未完成)



次回予定 [第 9 回目] 電磁誘導の法則 (教科書 136 ページまで)

レポート問題 第 8 回目 (右側の半分の解答用紙を切り取って提出しなさい)

数値で計算する問題は、答えにも必ず単位をつけること!

問 1 .

1本の電流 I (下から上に流れている) のまわりに、(下から見て) 右まわりの閉曲線 C をとったとき、アンペールの法則を書け。[教科書の式 (5.95)]
 (下から見て) 右まわりの閉曲線 C の中に、下から上に電流 I_1 と I_2 が、上から下に電流 I_3 が流れている。アンペールの法則を書け。[教科書の式 (5.96)]

問 2 .

アンペールの法則を使って、強さ I の直線電流のまわりの磁束密度の大きさ B を求めよ。
 単位長さ (1m) あたりの巻き数 n のソレノイドに、強さ I の電流が流れている。ソレノイドは無限に長いとし、アンペールの法則を使って、ソレノイド内部の磁束密度の大きさ B を求めよ。[問 5.51]

問 3 . 断面が半径 R の円形の、十分長い直円筒状の導体を、強さ I の定常電流が流れている。導体の中心からの距離を r とする。

電流密度 i を求めよ。

アンペールの法則を使って、導体の外側 ($r > R$) の磁束密度の大きさ B を求めよ。

アンペールの法則を使って、導体の内側 ($r < R$) の磁束密度の大きさ B を求めよ。

と の結果から、距離 r によって磁束密度の大きさ B が変化する様子をグラフに表せ。

解答用紙 学籍番号 _____ 氏名 _____

数値で計算する問題は、答えにも必ず単位をつけること！

問 1 .

問 2 .

直線電流を中心に半径 r の右まわりの円周を閉曲線 C にとる。

アンペールの法則は、 $\oint_C B_s ds = \mu_0 \cdot$ である。

直線電流のまわりには、円周にそって磁場ができるので、 $B_s = B$ である。

$\oint_C ds =$ (半径 r の円周の長さ) = だから

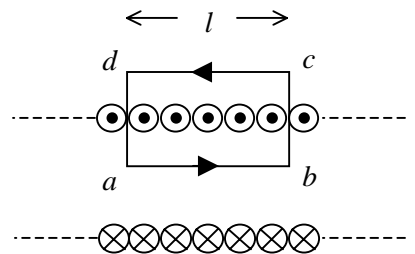
$$\oint_C B_s ds = B \oint_C ds = B \cdot \text{} = \mu_0 I$$

$$B =$$

十分長いソレノイドの外部では $B = 0$ ，線分 bc と da と B が垂直であることを使って，

$$\oint_{abcd} B_s ds = \text{} = \mu_0 \cdot \text{}$$

$$B =$$



問 3 .

$$i = \frac{I}{\text{(導体の断面積)}} =$$

導体の外部に、直円筒の中心から半径 $r (> R)$ の右まわりの円周を閉曲線 C にとる。この場合は、直線電流 I が作る磁場の求め方 (問 2 の) と同様にして、

$$B(r) =$$

次に、導体の内部に、直円筒の中心から半径 $r (< R)$ の右まわりの円周を閉曲線 C にとる。

閉曲線を縁とする面 $S = \pi r^2$ を貫いて流れる定常電流 I' は、 $I' = iS =$

$$\oint_C B_s ds = B \oint_C ds = B \cdot 2\pi r = \mu_0 I' = \text{}$$

$$B(r) =$$

グラフは裏に。 r を横軸に目盛り $0, R, 2R, 3R, \dots$ 、 B を縦軸に目盛り $0, 0.5 \cdot \mu_0 I / 2\pi R, \mu_0 I / 2\pi R$